



NMOS 数据手册

NP2002

18V 15A Advanced Trench NMOS

Rev. 1.0

请注意以下有关宁波宝芯源功率半导体知识产权政策

* 宁波宝芯源功率半导体有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

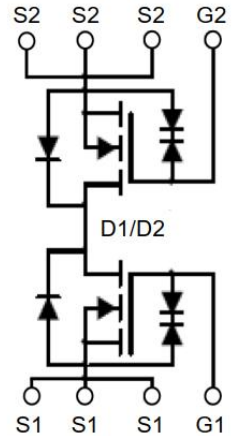
* 宁波宝芯源功率半导体有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站www.pwcore.com。

NMOS 18V/15A Dual N-Channel NP2002

产品特性 Features

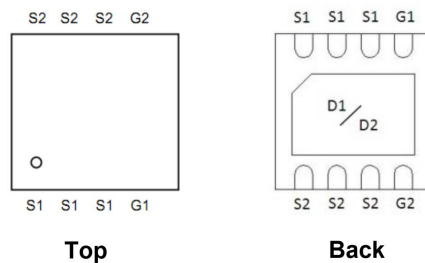
- ◆ 先进沟槽工艺技术 Advanced Trench Technology
- ◆ 超低栅极电荷 Super Low Gate Charge
- ◆ 超低 Ron 高密度单元设计 High Density Cell Design for Ultra Low Rdson
- ◆ RoHS 产品 RoHS Product



应用领域 Applications

- ◆ 负载开关 Load Switching

关键参数与封装信息 Key Performance and Package Parameters



DFN3X3-8L

产品型号 Part No.	封装 Package	漏极-源极电压 VDS	漏极电流 ID	导通电阻 RDS(on) Typ.
NP2002	DFN3X3-8L	18V	15A	3.8mΩ

最大额定值 Maximum Ratings

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit
最高漏极-源极直流电压 Drain to Source Voltage	V _{DS}	18	V
最高栅源电压 Gate to Source Voltage	V _{GS}	±10	V
连续漏极电流 Drain Current-Continuous, Limited by T _{vjmax} TC = 25° C TC = 100° C	I _D	15 10	A
最大脉冲漏极电流 Pulse Drain Current① PW≤300 μs, Duty Cycle≤2%	I _{Dpuls}	60	A
二极管正向电流 Diode Forward Current, Limited by T _{vjmax} TC = 25° C	I _S /I _{SM}	15/30	A
单脉冲雪崩能量 Single Pulsed Avalanche Energy②	E _{AS}	56	mJ
最大耗散功率 Maximum Power Dissipation TC = 25° C TC = 100° C	P _D	3 0.54	W
结温 Operating Junction Temperature	T _J	-55...+150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{stg}	-55...+150	°C
最高焊接温度 Maximum Soldering Temperature		260	°C
静电保护 (人体模型) ElectroStatic Discharge (HBM)	ESD	2K	V

① 脉冲宽度由最高结温限制 Pulse width limited by maximum junction temperature

② EAS 测试条件: T_J=25°C, V_{DD}=10V, L=0.5mH, R_g=25Ω

热阻特性 Thermal Resistance

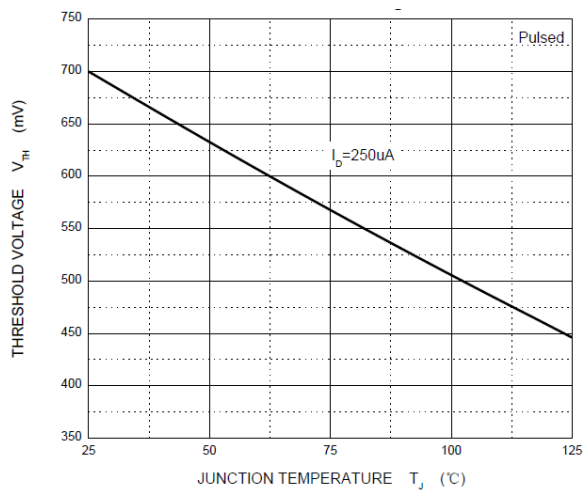
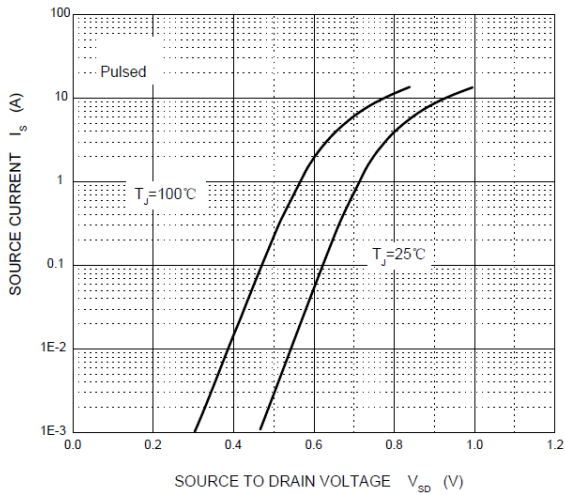
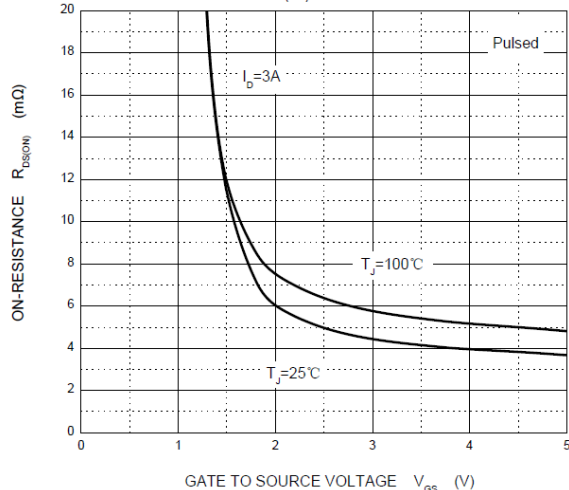
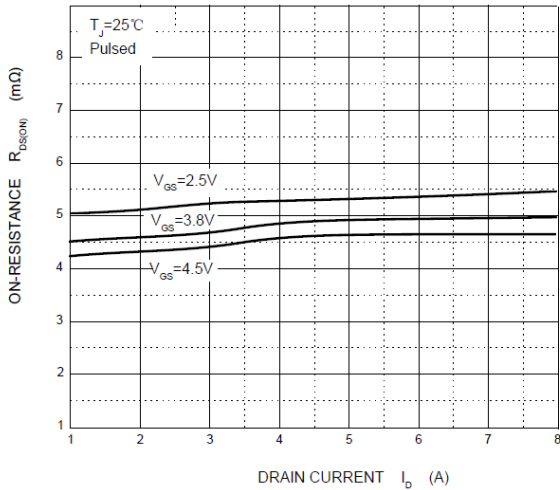
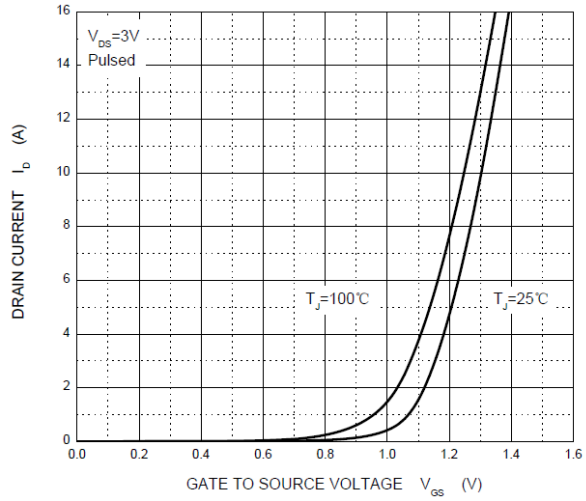
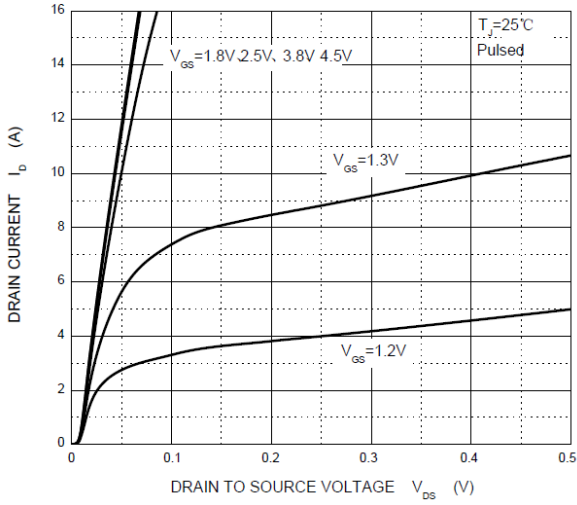
参数 Parameter	符号 Symbol	数值 (最大) Max. Value	单位 Unit
结到管壳热阻 Thermal Resistance Junction to Case	R _{θJC}	40	°C /W

③ Device on 40mm x 40mm x 1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm² (one layer, 7μm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical in still air.

电气特性 Electrical Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

项目 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Conditions	数值 Value			单位 Unit
			Min.	Typ.	Max.	
漏-源击穿电压 Drain to Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	18	-	-	V
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=18V, V_{GS}=0V$ $T_J=25^\circ C$ $T_J=150^\circ C$	-	-	1 100	μA
栅极漏电流 Gate to Source Leakage Current	I_{GSS}	$V_{DS}=0V, V_{GS}=\pm 10V$	-	-	± 10	μA
阈值电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	0.4	-	1.0	V
静态导通电阻 Drain to Source On-State Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=4.5V, I_D=3A$	-	3.8	5.3	$m\Omega$
		$V_{GS}=2.5V, I_D=3A$	-	5.0	6.5	$m\Omega$
正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$I_S=15A, V_{GS}=0V$	-	0.8	1.4	V
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=10V$ $V_{GS}=0V$ $f=1MHz$	-	1750	-	pF
输出电容 Output Capacitance	C_{oss}		-	283	-	pF
反向传输电容 Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		-	257	-	pF
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS}=10V$ $V_{GS}=4.5V$ $I_{DS}=3A$	-	24	-	nC
栅极-源极电荷 Gate to Source Charge	Q_{gs}		-	2.2	-	
栅极-漏极电荷 Gate to Drain Charge	Q_{gd}		-	6.8	-	
开启延迟时间 Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$T_J=25^\circ C$ $V_{DD}=10V, I_D=3A$ $V_{GS}=4.5V,$ $R_G=3\Omega$	-	4.0	-	ns
上升时间 Rise Time	t_r		-	8.0	-	
关断延迟时间 Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$		-	74	-	
下降时间 Fall Time	t_f		-	22	-	
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=3A, di/dt=100A/\mu s$	-	21	-	ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}		-	9	-	nC

特征曲线 Characteristic Curve



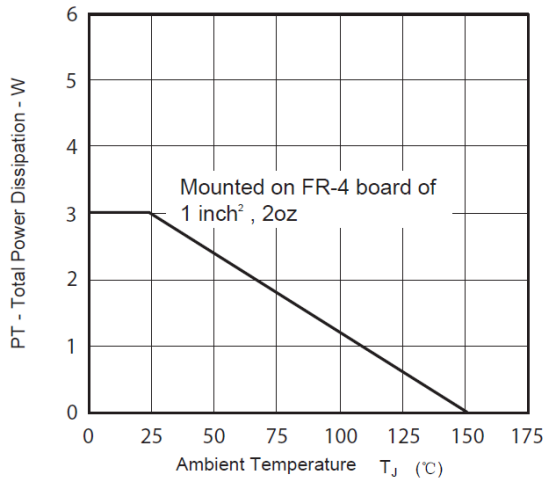


Fig.7 TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE

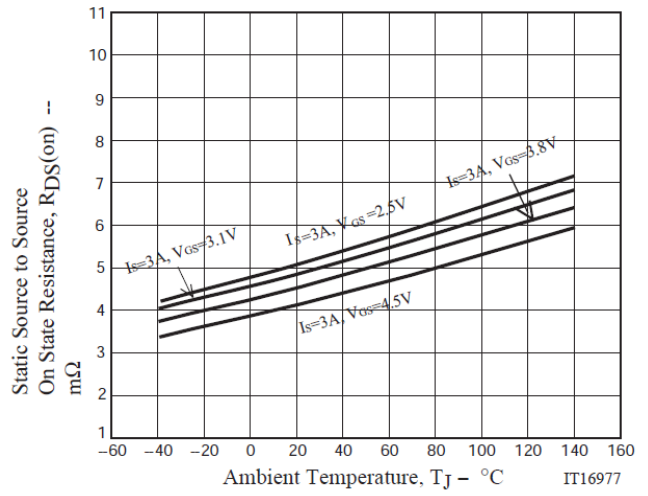


Fig. 8 $R_{DS(ON)}$ vs T_A

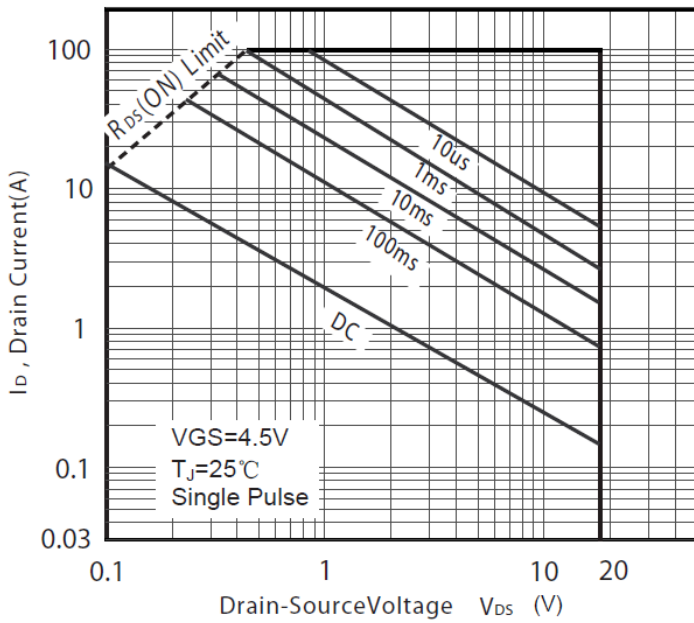
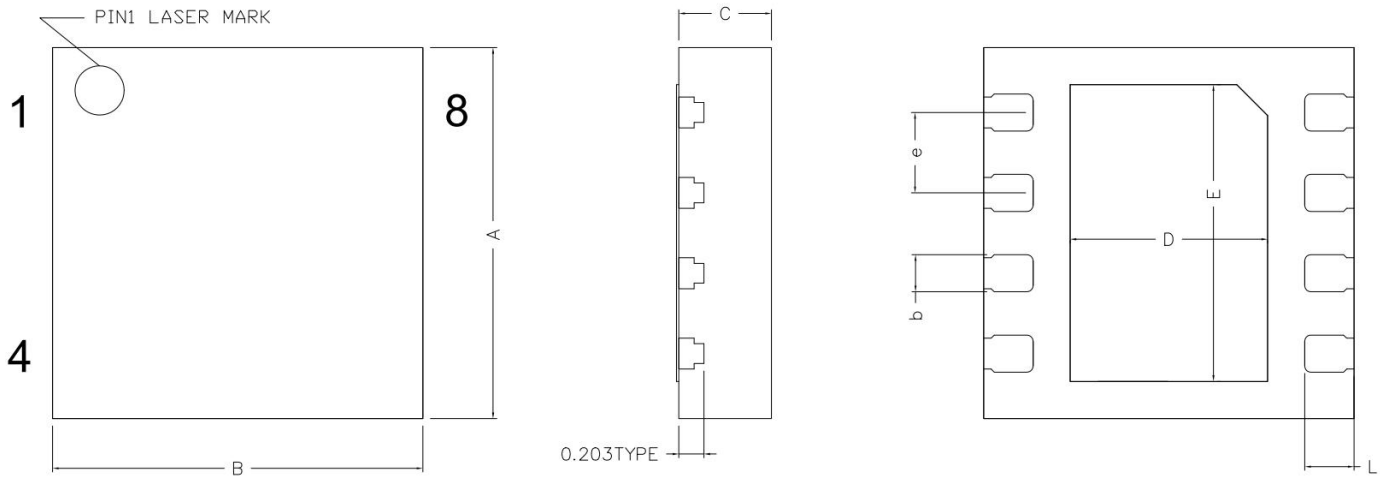


Fig.9 Safe Operating Area

Notes:

Pulse Test: Pulse Width $\leq 380 \mu s$, Pulse Delay $\leq 200 \mu s$.

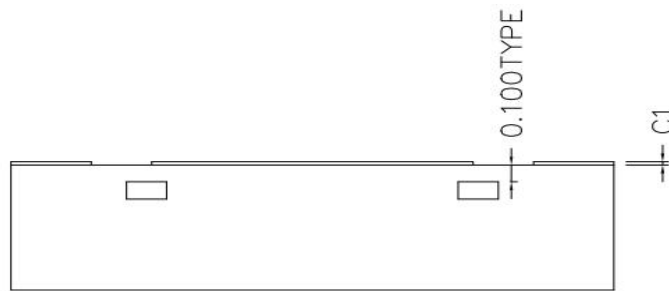
外形尺寸Mechanical Data:PFN3*3-8L



TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTEM VIEW



SIDE VIEW

COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE IS mm)			
	MIN	NORMAL	MAX
A	2.900	3.000	3.100
B	2.900	3.000	3.100
C	0.700	0.750	0.800
C1	0.005	—	0.020
D	1.500	1.600	1.700
E	2.300	2.400	2.500
L	0.350	0.400	0.450
b	0.250	0.300	0.350
e	0.650 TYPE		

历史版本

版本号	时间	修改内容
V1.0	2023 年 9 月	初始版本